

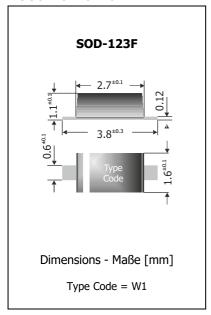
1N4148W, 1N4448W

SMD Small Signal Switching Diodes SMD Kleinsignal-Schaltdioden

 $I_{FAV} = 150 \text{ mA}$ $V_{F1} < 0.855 V$ $T_{imax} = 150$ °C

 $V_{RRM} = 100 V$ $I_{\text{FSM1}} = 1 \text{ A}$ < 4 ns

Version 2017-01-26



Typical Applications

Signal processing, High-speed switching Commercial grade 1)

Features

Low profile plastic package Very high switching speed Low junction capacitance Low leakage current Compliant to RoHS, REACH, Conflict Minerals 1)

Mechanical Data 1)

Taped and reeled Weight approx. Case material Solder & assembly conditions

Typische Anwendungen

Signalverarbeitung, Schnelles Schalten Standardausführung 1)

Besonderheiten

Flaches Kunststoff-Gehäuse Extrem schnelles Schalten Niedrige Sperrschichtkapazität **Niedriger Sperrstrom** Konform zu RoHS, REACH, Konfliktmineralien 1)

Mechanische Daten 1)

3000 / 7" Gegurtet auf Rolle 0.01 gGewicht ca. UL 94V-0 Gehäusematerial 260°C/10s Löt- und Einbaubedingungen

MSL = 1

These diodes are available in alternative case outlines	DO-35 = 1N4148	1N 444 8
Diese Dioden sind auch in alternativen Gehäuseformen lieferbar	MiniMELF = LL4148	LL4448
	Q-MiniMELF = LS4148	LS4448
	Q-MicroMELF = MCL4148	MCL4448
	SOD-323F = 1N4148WS	1N 444 8WS

Maximum ratings 2) Grenzwerte 2)

Power dissipation – Verlustleistung		P _{tot}	400 mW ³)	
Max. average forward current – Dauergrenzstrom	average forward current – Dauergrenzstrom DC		150 mA ³)	
Repetitive peak forward current – Periodischer Spitzenstrom		I_{FRM}	300 mA ³)	
Non repetitive peak forward surge current Stoßstrom-Grenzwert	$\begin{array}{l} t_{p} \leq 1 \text{ s} \\ t_{p} \leq 1 \text{ ms} \\ t_{p} \leq 1 \mu \text{s} \end{array}$	${ m I}_{\sf FSM}$	0.5 A 1 A 4 A	
Reverse voltage Sperrspannung		V_R	75 V	
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung		V _{RRM}	100 V	
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T _j Ts	-55+150°C -55+150°C	

Please note the <u>detailed information on our website</u> or at the beginning of the data book Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches

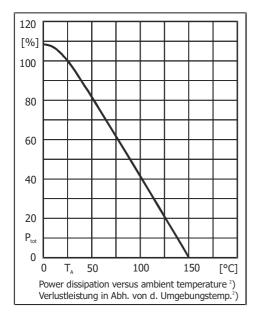
 $T_A = 25$ °C unless otherwise specified – $T_A = 25$ °C wenn nicht anders angegeben

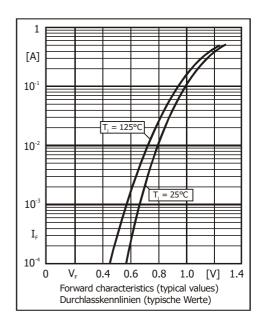
Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss



Characteristics Kennwerte

					1N4148W	1N4448W
Forward voltage Durchlass-Spannung	T _j = 25°C	I _F =	1 mA 5 mA 10 mA 50 mA 150 mA	V _F	< 0.715 V - < 0.855 V < 1 V < 1.25 V	- 0.620.72 V < 0.855 V < 1 V < 1.25 V
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25$ °C	$V_R =$	20 V 75 V	I_{R}	< 25 nA < 1 μA	< 25 nA < 100 nA
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 150$ °C	$V_R =$	20 V 75 V	I_{R}	< 30 μA < 50 μA	< 30 μA < 50 μA
Junction capacitance – Sperrschichtkapazität	$V_R = 0 V, f = 1 MHz$		C_{T}	typ.	2 pF	
Reverse recovery time – Sperrverzug			t _{rr}	< 4 ns ¹)		
Thermal resistance junction to ambient Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung			R_{thA}	< 312 K/W ²)		





Disclaimer: See data book page 2 or <u>website</u> **Haftungssauschluss:** Siehe Datenbuch Seite 2 oder <u>Internet</u>

2 http://www.diotec.com/ © Diotec Semiconductor AG

¹ I_{F} = 10 mA über/through I_{R} = 10 mA bis/to I_{R} = 1 mA

² Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss